

# SiPM Tests

2026.04.17

# 1. 击穿电压

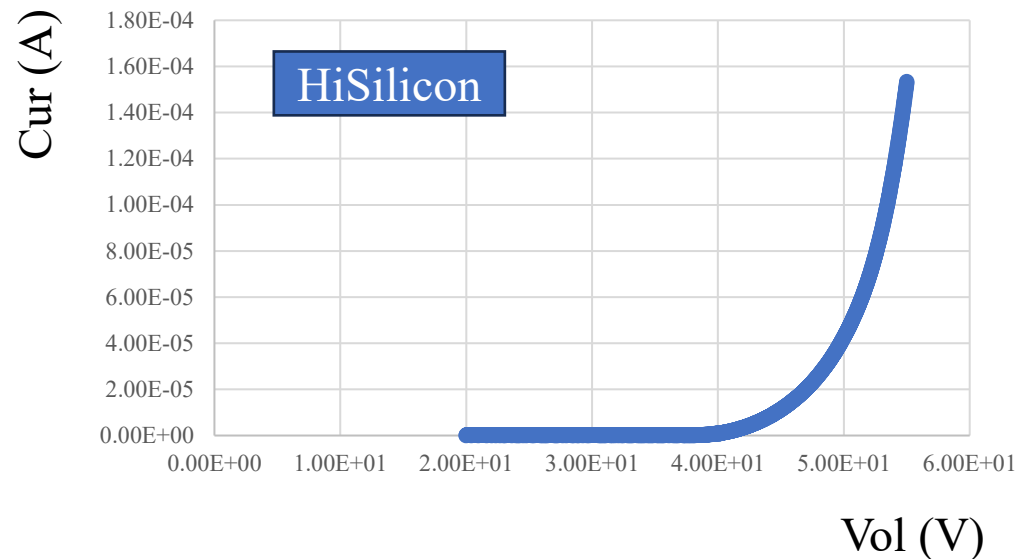
## GSM-20H10源表



✓ 各型号SiPM的IU曲线已测试完成

□ 分析代码

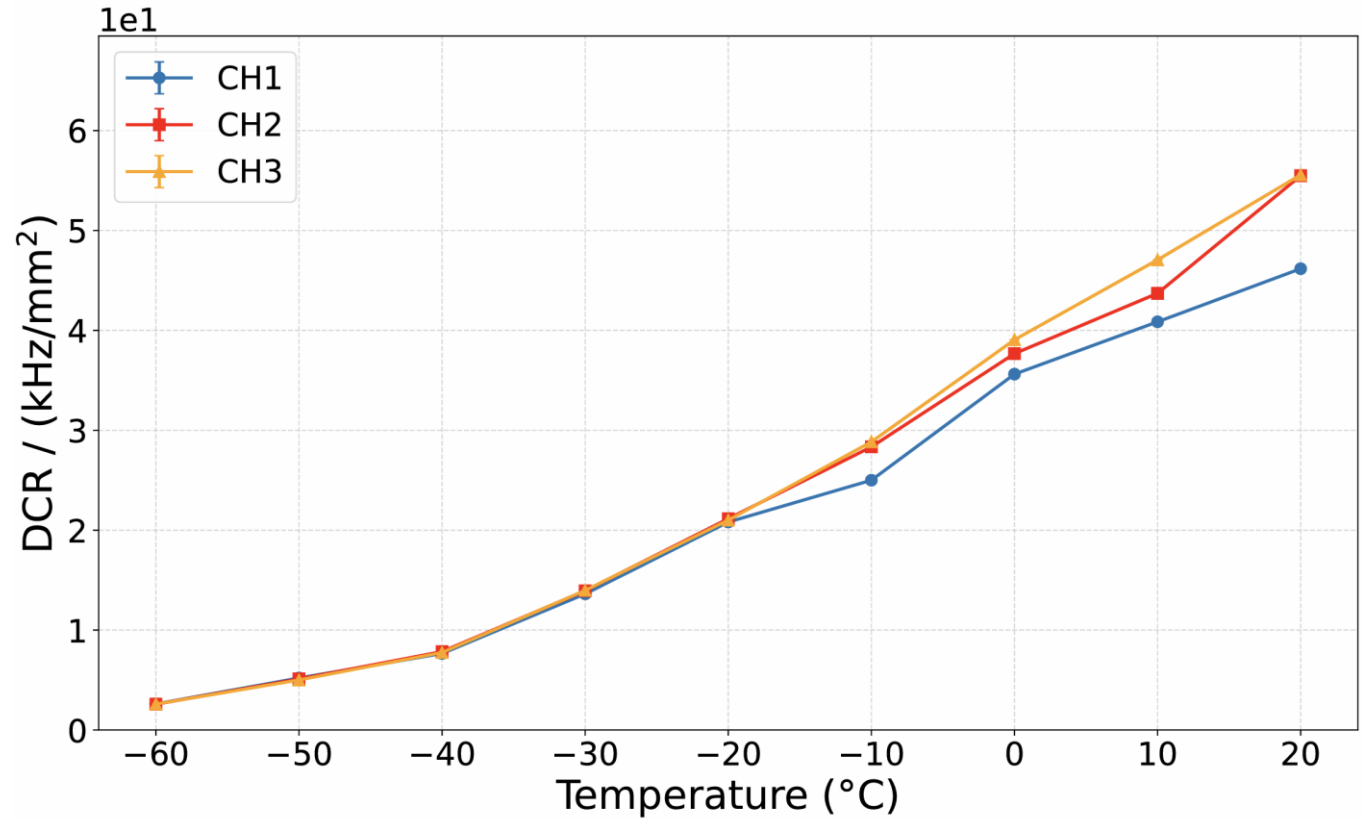
Point	Vol(V)	Cur(A)	Time(S)
0	2.00E+01	1.30E-08	0
1	2.00E+01	2.71E-07	0.024
2	2.00E+01	3.26E-07	0.048
3	2.00E+01	2.60E-07	0.072
4	2.01E+01	2.67E-07	0.113
5	2.01E+01	3.64E-07	0.137
6	2.01E+01	2.68E-07	0.161
7	2.01E+01	2.77E-07	0.185
8	2.01E+01	2.82E-07	0.209
9	2.01E+01	1.62E-07	0.249
10	2.01E+01	3.06E-07	0.273
11	2.02E+01	2.74E-07	0.297
12	2.02E+01	3.57E-07	0.321
13	2.02E+01	2.87E-07	0.357
14	2.02E+01	3.14E-07	0.385
15	2.02E+01	3.57E-07	0.41
16	2.02E+01	2.90E-07	0.434



## 2. 低温测试 (PSS 11-6060-S)

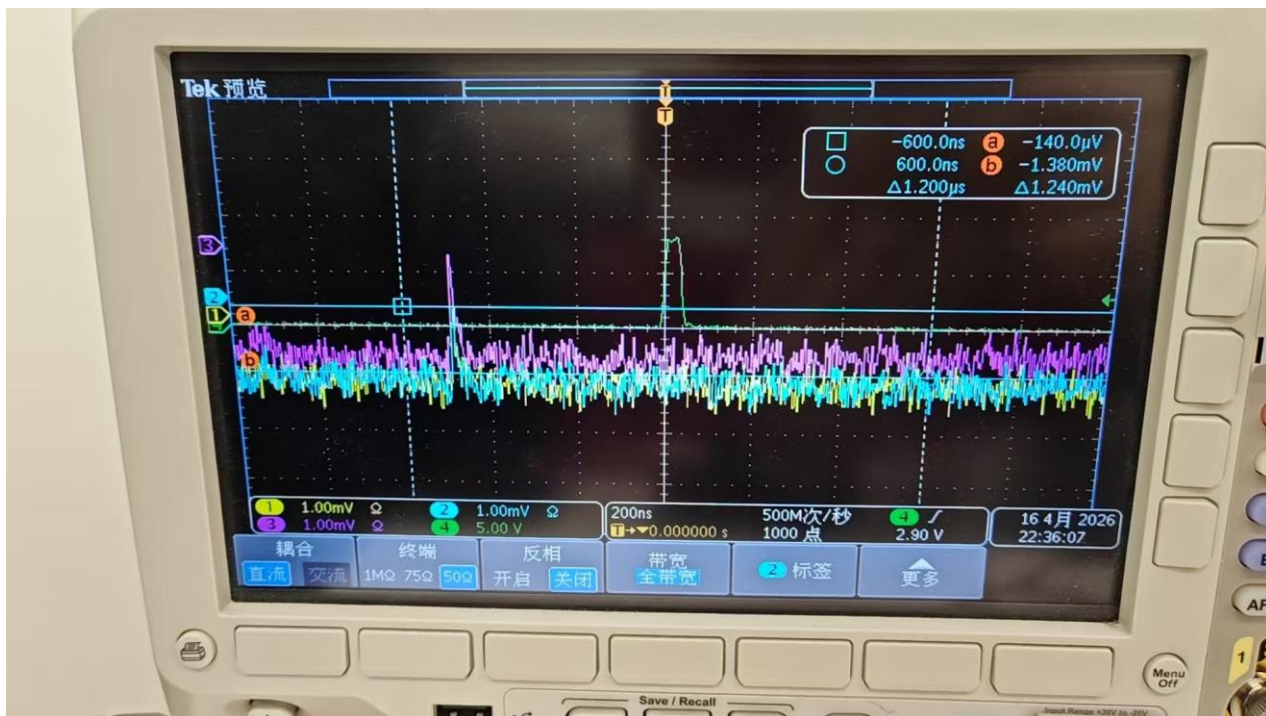


- 测试电压: 32V
- 测试温度: -60 至 20 摄氏度, 步长10摄氏度
- ❑ DCR数值需要Cross Check, 因为信号幅度较小



## 2. 低温测试 (PSS 11-6060-S)

工作电压32V



- 信号幅度小 (1点多mV), 可能会影响寻峰
- 考虑接二级放大, 或将CH叠加?
- 串扰比较难定准

